

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 19130

Цена в прайсе: 330 тг.

MOSFET транзистор NCE30P30K, P-канал, -30 В, -30 А, TO-252-2L



NCE30P30K — P-канальный силовой MOSFET производства Wuxi NCE Power Semiconductor с напряжением сток-исток **-30 В**, постоянным током стока до **-30 А** и сопротивлением открытого канала до **18 мОм при $V_{GS} = -10 В$** . Выполнен в корпусе **TO-252-2L (DPAK)** для поверхностного монтажа

NCE30P30K представляет собой **P-канальный MOSFET с индуцированным каналом**, разработанный для коммутации сравнительно больших токов при низком напряжении. Производитель использует trench-структуру, обеспечивающую низкое сопротивление открытого канала и сравнительно небольшой заряд затвора.

Максимальное напряжение **V_{DS} составляет -30 В**, а непрерывный ток стока при температуре корпуса 25 °С — **-30 А**. При 100 °С допустимый непрерывный ток снижается до **-21,2 А**. В версии datasheet v1.1 максимальный импульсный ток указан как **-120 А**.

Сопротивление открытого канала составляет максимум **18 мОм при $V_{GS} = -10 В$ и $I_D = -20 А$** , либо максимум **30 мОм при $V_{GS} = -4,5 В$ и $I_D = -15 А$** . Это позволяет использовать транзистор в высокоточных ключах с относительно небольшими проводниковыми потерями.

Характеристики

- **Маркировка:** NCE30P30K
- **Тип:** силовой MOSFET
- **Канал:** P-канальный
- **Режим:** Enhancement Mode
- **Максимальное напряжение сток-исток, V_{DS} :** -30 В

- **Максимальное напряжение затвор-исток, VGS:** ± 20 В
- **Постоянный ток стока, ID:** -30 А при $T_C = 25$ °C
- **Постоянный ток стока при $T_C = 100$ °C:** $-21,2$ А
- **Импульсный ток стока, IDM:** -120 А по datasheet v1.1
- **Максимальная рассеиваемая мощность, PD:** 60 Вт
- **RDS(on):** ≤ 18 мОм при $V_{GS} = -10$ В, $I_D = -20$ А
- **RDS(on):** ≤ 30 мОм при $V_{GS} = -4,5$ В, $I_D = -15$ А
- **Пороговое напряжение VGS(th):** от $-1,2$ до $-2,5$ В; тип. $-1,6$ В
- **Заряд затвора Qg:** тип. 31,2 нКл
- **Заряд затвор-исток Qgs:** тип. 3,2 нКл
- **Заряд затвор-сток Qgd:** тип. 9,2 нКл
- **Входная ёмкость Ciss:** тип. 1363 пФ
- **Выходная ёмкость Coss:** тип. 250 пФ
- **Обратная передаточная ёмкость Crss:** тип. 210 пФ
- **Прямое напряжение встроенного диода VSD:** до $-1,2$ В
- **Ток встроенного диода IS:** до -20 А
- **Время обратного восстановления trr:** тип. 24 нс
- **Энергия одиночного лавинного импульса EAS:** 169 мДж
- **Тепловое сопротивление переход-корпус RθJC:** 2,5 °C/Вт
- **Рабочая температура перехода:** $-55...+175$ °C
- **Корпус:** TO-252-2L / DPAK
- **Монтаж:** SMD
- **Исполнение:** Pb-Free